

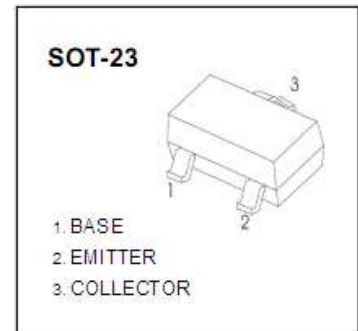
印章/Marking: G1

特点/Features:

击穿电压高;

用途/Applications:

用于普通高压放大, 与 MMBT5401 互补。



极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

| 参数/Parameter | 符号/ Symbol | 数值/Value | 单位/Unit |
|--------------------------------------|------------|----------|---------|
| 集电极-基极电压/Collector-Base Voltage | V_{CB0} | 180 | V |
| 集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage | V_{CE0} | 160 | V |
| 发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage | V_{EB0} | 6 | V |
| 集电极连续电流/Collector Current Continuous | I_C | 0.6 | A |
| 集电极耗散功率/Collector Power Dissipation | P_C | 0.3 | W |
| 结温/Junction Temperature | T_j | 150 | °C |
| 储存温度/Storage Temperature | T_{stg} | -55~150 | °C |

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|-----------------|----------------------------------|-----|------|---------|
| 集电极-基极击穿电压 | $V_{BR(CB0)}$ | $I_C=100\mu A, I_E=0$ | 180 | | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | $V_{BR(CE0)}$ | $I_C=1mA, I_B=0$ | 160 | | V |
| 发射极-基极击穿电压 | $V_{BR(EB0)}$ | $I_E=10\mu A, I_C=0$ | 6 | | V |
| 集电极截止电流 | I_{CB0} | $V_{CB}=120V, I_E=0$ | | 0.1 | μA |
| 发射极截止电流 | I_{EB0} | $V_{EB}=4V, I_C=0$ | | 0.1 | μA |
| 直流电流增益 | $h_{FE(1)}^*$ | $V_{CE}=5V, I_C=1mA$ | 80 | | |
| 直流电流增益 | $h_{FE(2)}^*$ | $V_{CE}=5V, I_C=10mA$ | 100 | 300 | |
| 直流电流增益 | $h_{FE(3)}^*$ | $V_{CE}=5V, I_C=50mA$ | 50 | | |
| 集电极-发射极饱和压降 | $V_{CE(sat)}^*$ | $I_C=10mA, I_B=1mA$ | | 0.15 | V |
| 集电极-发射极饱和压降 | $V_{CE(sat)}^*$ | $I_C=50mA, I_B=5mA$ | | 0.2 | V |
| 基极-发射极饱和压降 | $V_{BE(sat)}^*$ | $I_C=10mA, I_B=1mA$ | | 1 | V |
| 基极-发射极饱和压降 | $V_{BE(sat)}^*$ | $I_C=50mA, I_B=5mA$ | | 1 | V |
| 特征频率 | f_T | $V_{CE}=10V, I_C=10mA, f=100MHz$ | 100 | 300 | MHz |
| 输出电容 | C_{OB} | $V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$ | | 6 | pF |
| 输入电容 | C_{IB} | $V_{BE}=0.5V, I_C=0, f=1MHz$ | | 20 | pF |

*pulse test



典型特性曲线图/Typical Characteristics

